

# STA341M

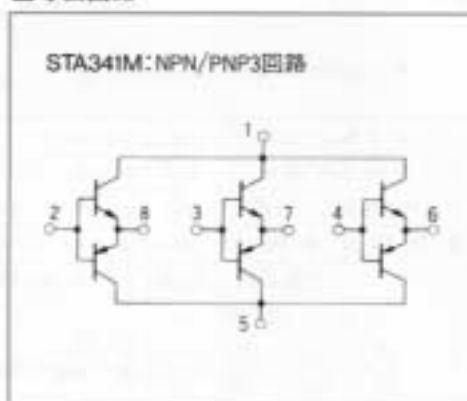
NPN  
PNP シリコン三重拡散プレーナ型 トランジスタ(K)

- 特長**
- 高密度実装型。
  - 特性バラツキが少ない。

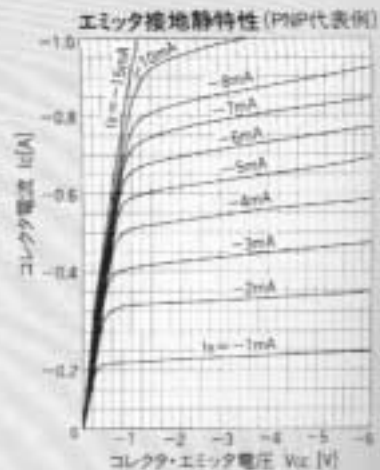
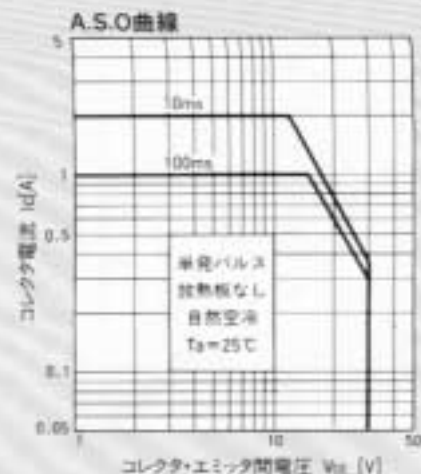
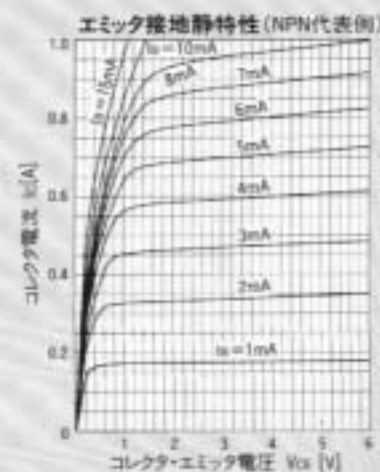
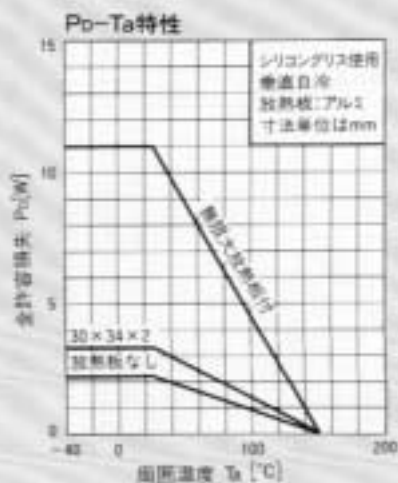
■絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格値		単位
		NPN	PNP	
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CB</sub>	30	-30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CE</sub>	30	-30	V
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EB</sub>	6	-6	V
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	1	-1	A
ベース電流	I <sub>B</sub>	0.1	-0.1	A
全許容損失 (Tc = 25°C)	P <sub>C</sub>	2.2		W
接合部温度	T <sub>J</sub>	150		°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +150		°C

■等価回路



## 特性曲線



■電気的特性

( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	記号	NPN			PNP			単位
		条件	規格値		条件	規格値		
			最小	標準		最大	最小	
コレクタ・エミッタ断電流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=30\text{V}, I_B=0$		10	$V_{CE}=-30\text{V}, I_B=0$		-10	$\mu\text{A}$
エミッタ・エミッタ断電流	$I_{ESE}$	$V_{BE}=6\text{V}, I_C=0$		10	$V_{BE}=-6\text{V}, I_C=0$		-10	$\text{mA}$
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=0$	30		$I_C=-10\text{mA}, I_B=0$	-30		$\text{V}$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=0.3\text{A}$	100		$V_{CE}=-4\text{V}, I_C=-0.3\text{A}$	100		
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=300\text{mA}, I_B=10\text{mA}$		0.5	$I_C=-300\text{mA}, I_B=-10\text{mA}$		-0.5	$\text{V}$
ターンオン時間	$t_{on}$	$I_C=0.3\text{A}$		0.22	$I_C=-0.3\text{A}$		0.25	$\mu\text{s}$
蓄積時間	$t_s$	$I_{B1}=-I_{B2}=10\text{mA}$		1.4	$-I_{B1}=I_{B2}=10\text{mA}$		0.54	$\mu\text{s}$
下降時間	$t_r$			0.28			0.3	$\mu\text{s}$

